



Aalto-yliopisto
Sähkötekniikan
korkeakoulu

Sähkötekniikka ja elektroniikka

Kimmo Silvonen (X)

28.10.2020

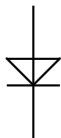
Diodi ja puolijohteet

Luento 28.10.2020

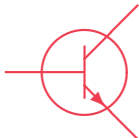
- ▶ Ideaalidiodi = kytkin
- ▶ Puolijohdediodi = epälineaarinen vastus
- ▶ Sovelluksia, mm. ilmaisimien ja LED, tasasuuntaus viim. viikolla
- ▶ Pii ja doping eli seostus epäpuhtauksilla
- ▶ *pn*-liitos
- ▶ Päästösuunta vs. estosuunta
- ▶ Elektronikka on epälineaarista \Rightarrow iterointi
- ▶ D.C. vs. signaali, piensignaali-approksimaatio
- ▶ Kaaosteoria ja "Chuan diodi"
- ▶ Ensi viikolla: bipolaaritransistori (BJT)
- ▶ Lisätietoja: Elektronikka ja sähkötekniikka, 2018

Mistä elektroniikka koostuu (s.l.)

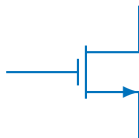
- ▶ Puolijohdekomponentit:
 - ▶ Diskreetit, esim. *Diodi*, *BJT*, *FET*
 - ▶ Monoliitti-*IC*, esim. *Opamp*, *CMOS*, *ASIC*
 - ▶ Hybridi-*IC*, esim. monet *RF*-mikropiirit
- ▶ "Passiivit": *R*, *L*, *C*, siirtojohto, muuntaja, ym.
- ▶ Anturi, toimilaite, muutin (*sensor*, *actuator*, *transducer*)
- ▶ Näytöt, liitännät, ohjelmistot



Diodi



Transistori BJT

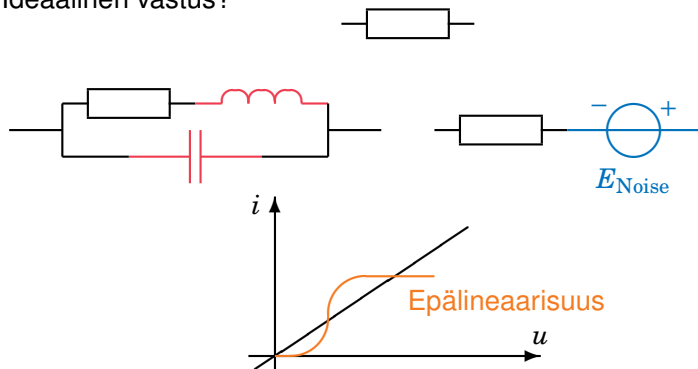


Kanavatransistori (MOS)FET

Parasiitit, kohina, särö

Elektroniikan komponentit ovat epäideaalisia, loissuureet ovat aina läsnä!

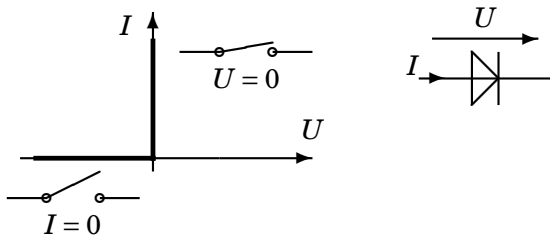
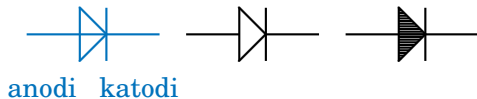
Ideaalinen vastus?



Kohinaa syntyy kaikkialla ja epälineaarisuus tuottaa säröä.

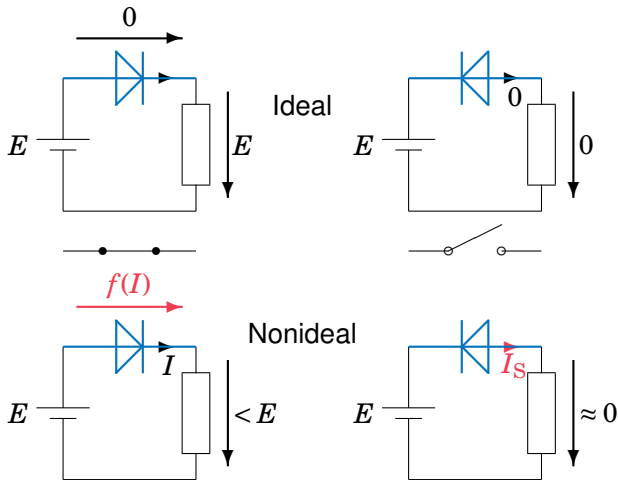
Ideaalidiodi, cf. Switch

Voidaan mallintaa kytkimellä



Ideaalidiodi vs. puolijohdediodi (alla)

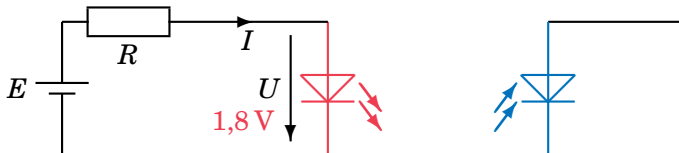
Päästösuunta/estosuunta. *Ideal Diode vs. Semiconductor Diode, forward/reverse.*



LED = loistediodi vs. fotodiodi

Myös laserdiodi (optinen tietoliikenne) ja IR = *infrared*

Esimerkkinä LED merkkivalona, oikealla fotodiodi:



vrt. kaukosäädin, langaton näppäimistö/hiiri

Ledeillä ja muilla diodeilla sallittu jänniteikkuna on hyvin kapea: U hieman liian pieni \Rightarrow ei johda, U hieman liian suuri \Rightarrow kärkehtää!

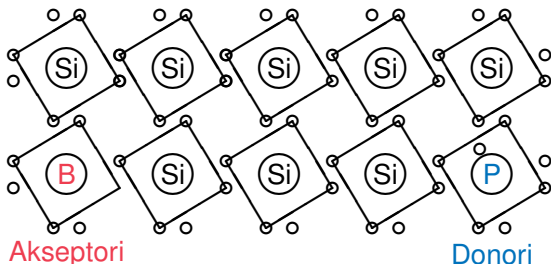
Seostettu puolijohde, *pn*-liitos

Doping, pn-junction, piihin on seostettu heikosti booria tai fosforia

Kovalenttinen sidos

(Si) IV + III (B) = p-
tyyppinen puolijohde

(Si) IV + V (P) = n-
tyyppinen puolijohde

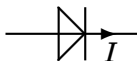
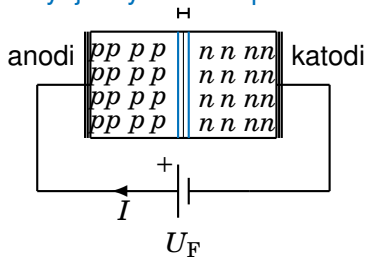


Päästösuunta, *Forward Bias*

Tyhjennysalue *Depletion Region decreases due to the forward Voltage*

n = elektronit, p = aukot

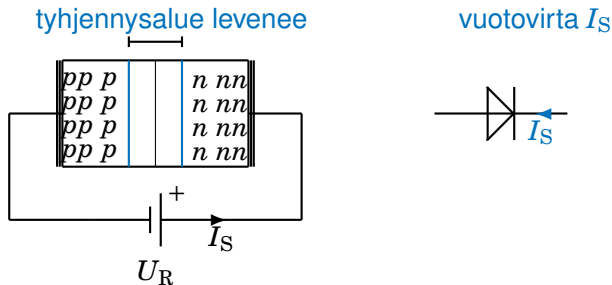
tyhjennysalue kapenee



Estosuunta, *Reverse Bias*

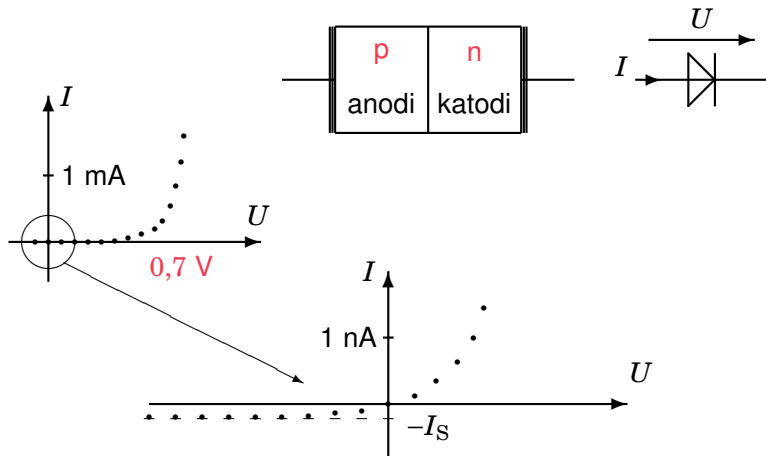
Depletion Region increases, but a small Saturation Current leaks

Saturaatiovirta I_S (estosuuntainen vuotovirta)
ei juuri riipu jännitteestä \Rightarrow 'kyllästysvirta'



Puolijohdediodi, *pn*-liitos

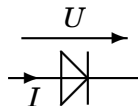
Semiconductor Diode, *pn*-junction; 0,7 V (vrt. lab.)



Ominaiskäyrä $i = f(u)$ ja Einsteinin yhtälö: U_T

Characteristic Curve

Epälineaarinen vastus



$$I = I_S(e^{\frac{U}{nU_T}} - 1) \approx \begin{cases} I_S e^{\frac{U}{nU_T}} & U \gg nU_T \\ 0 & U \approx 0 \\ I_S(-1) & U \ll 0 \end{cases}$$

$$U_T = \frac{kT}{q} \approx 25 \text{ mV} \quad q = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ As} \quad k = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$$

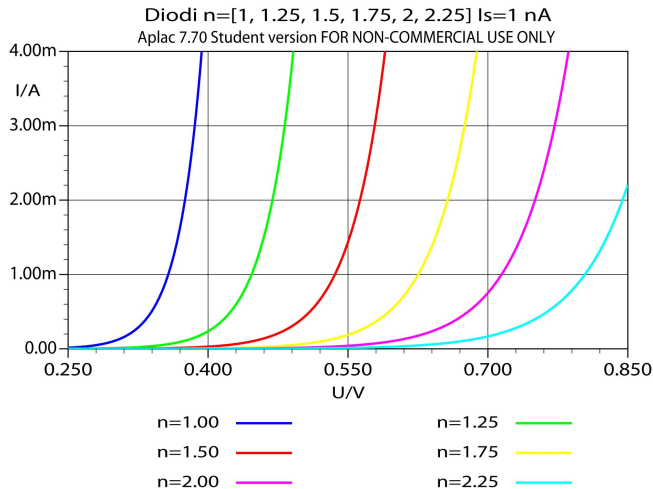
'Lämpöjännite'

Alkeisvaraus

'Boltzimienn' vakio

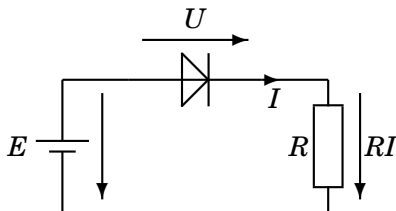
Emissiokerroin $n \approx 2$ (Diode), $n \approx 1$ (BJT)

Emission Coefficient, Ideality Factor



Epälineaarinen yhtälö

Nonlinear Equation



$$U = E - RI$$

$$U = E - RI_S(e^{\frac{U}{nU_T}} - 1)$$

Newton-Raphson-iterointi:

Iterointi

Kokeillaan eri U :n arvoilla

$$E = 10 \text{ V}, R = 1 \text{ k}\Omega, I_S = 1 \text{ nA}, n = 2, U_T = 25 \text{ mV}$$

U/V	$U \approx E - RI_S e^{\frac{U}{nU_T}}/\text{V}$	
0,7	8,80	$\gg 0,7$
0,8	1,11	$> 0,8$
0,81	-0,85	$< 0,81$
0,802	0,75	$\approx 0,80$
0,801727	0,802 \Rightarrow	$U \approx 0,802 \text{ V}$

$$I = \frac{E - U}{R} \approx 9,198 \text{ mA}$$

$$I = I_S(e^{\frac{U}{nU_T}} - 1) \approx 9,249 \text{ mA}$$

Tasavirta ja signaali *DC vs. signal*

Kansainvälinen merkintäsopimus (IEC): *total u or i = DC + pure signal*

Tasavirta: iso kirjain, iso alaindeksi: $U_D = R_D I_D$

Signaali: pieni kirjain, pieni alaindeksi: $u_d = r_d i_d$

Kokonaisvirta: pieni kirjain, iso alaindeksi:

$$u_D = U_D + u_d \quad U_D = u_{AVE} \quad u_d = \Delta u_D$$

$$i_D = I_D + i_d \quad I_D = i_{AVE} \quad i_d = \Delta i_D$$

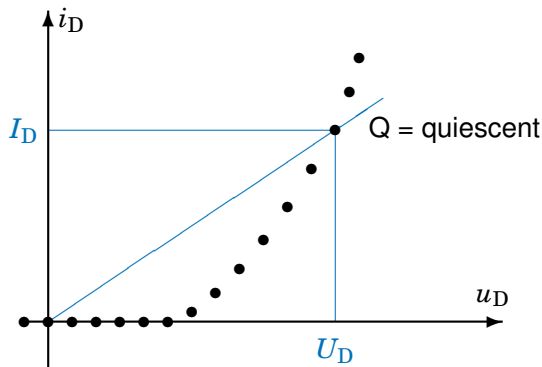
IEC = *International Electrotechnical Commission*

Toimintapiste ja staattinen resistanssi

Operating Point Q, static (DC) Resistance R_D

$$u_D = U_D = U_Q = R_D I_D$$

$$i_D = I_D = I_Q = I_S \left(e^{\frac{U_D}{nU_T}} - 1 \right)$$

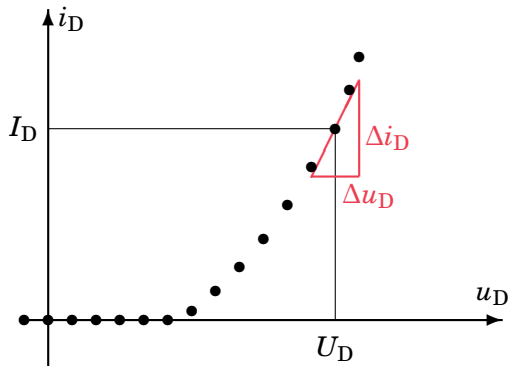


Dynaaminen resistanssi, muutos käyrällä

Dynamic (ac) Resistance near the Operating Point

$$i_D = I_S(e^{\frac{u_D}{nU_T}} - 1)$$

$$r_d = \frac{\Delta u_D}{\Delta i_D} \approx \frac{nU_T}{I_D}$$



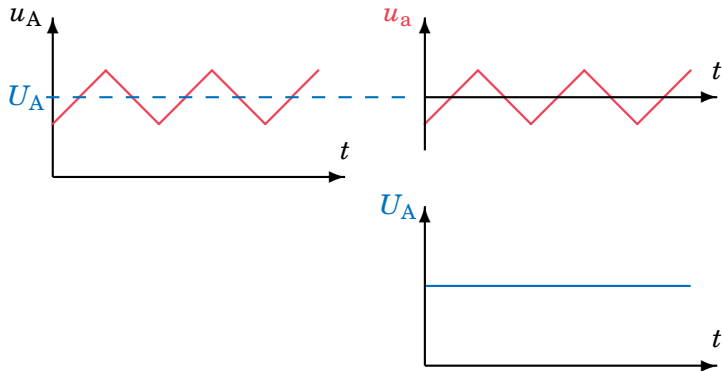
Piensaaliaalyysi

Small-Signal Analysis

- ▶ Signaalin käyttäytyminen epälineaarisissa komponenteissa
- ▶ Käyrän linearisointi toimintapisteessä; siksi 'vain' **pien...**
- ▶ Lineaarisilla komponenteilla, kuten R , ei ole eroa 'pien' vs. 'suur'
- ▶ DC-lähteitä ei oteta huomioon, nollataan
- ▶ Esim. vahvistimen vahvistus ja tuloresistanssi lasketaan piensaaliaalyysilla

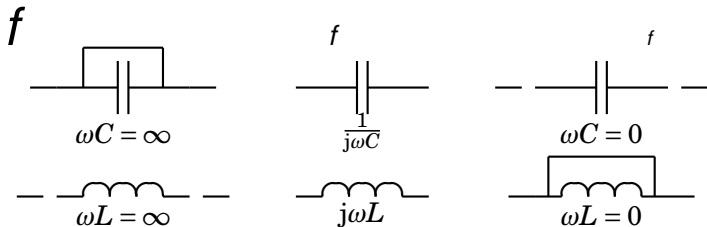
Tasajännitteen päällä ratsastava signaali

Little red signal riding on a smooth d.c.



Hyvin suuri – keskisuuri – hyvin pieni taajuus

Taajuusalueapproksimaatiot ja komponenttien käsittely

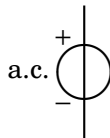
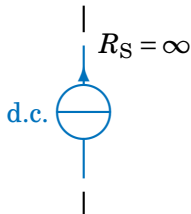
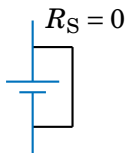


D.c.-lähteiden nollaus

Linear

Epälin.

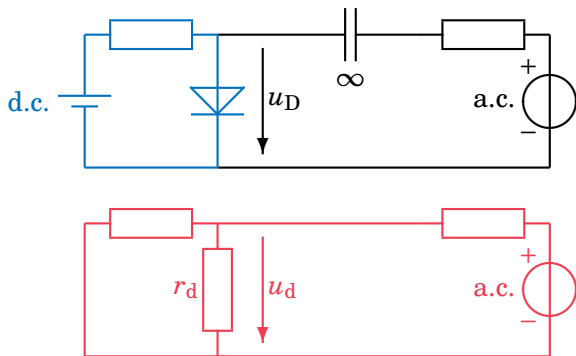
Signaalilähteet



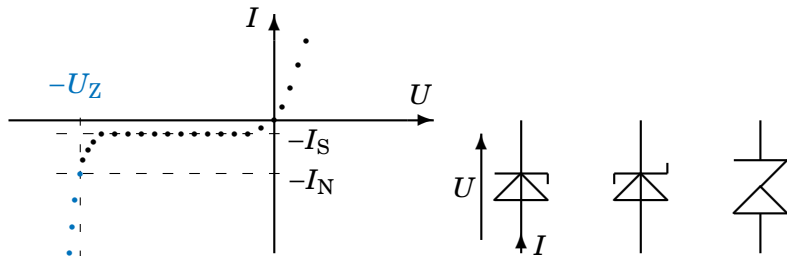
Tasavirta- vs. piensignaalianalyysi

DC vs. Small Signal Analysis

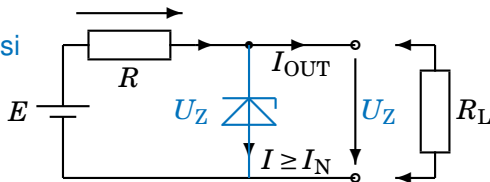
Signaali läpäisee tasajännitelähteen ja ison kondensaattorin. Epälineaarinen komponentti näkyy dynaamisen resistanssin määräämänä vastuksena r_d (approksimaatio).



Zeneriodi, Voltage Reference for small I_{OUT}



Jännitereferenssi
(pieni I_{OUT})



$$E \geq R(I_{OUT} + I_N) + U_Z$$

Chua's Circuit, *Butterfly Effect*

Yksinkertaisin mahdollinen kaottisesti toimiva piiri, ks. *chua-circuit.i.txt*

Yleinen kaaosteorian testialusta.

Vasemmalla Chuan diodi (negatiivista resistanssia sisältävä epälineaarinen komponentti, joka tosin ei ole diodi).

MyCossa *APLAC-netlist*, piirrä(n) $y = u_2$ vs. $x = u_1$

